# **U** TEXAS INSTRUMENTS

#### 摘要

TLVM13610 同步降压电源模块具有 3V 至 36V 的输入工作电压范围和高达 8A 的额定输出电流,可为各种应用提供灵活性、可扩展性和优化的解决方案尺寸。通过集成功率 MOSFET、降压电感器和 PWM 控制器,这些模块可实现具有高密度、低 EMI 和更简化设计的直流/直流解决方案。

表 1-1. TLVM13610	同步降压直流/直流电源模块系列
------------------	-----------------

直流/直流模块	额定值 IOUT	封装	尺寸	特性	降低 EMI
TLVM13610	8A	B3-QFN (22)	6.5 × 7.5 (mm)	RT 调节的 F <sub>SW</sub>	压摆率控制、集成输入、VCC 和启动 电容器

TLVM13610EVM 使用 TLVM13610 易于使用的同步降压模块 IC,其输出电压范围为 1V 至 9V,输出电流高达 8A。EVM 的默认输出电压设置为 5V,可通过跳线设置调节为 3.3V。

该解决方案支持可调节输入电压 UVLO,以满足应用特定的上电和断电要求,支持用于时序控制和输出电压监控的 PGOOD 指示器,并设置为 AUTO 模式,以便在轻负载应用中实现高效率。



内容					
1 高密度 EVM 说明	4				
1.1 典型应用	4				
2 测试装置和过程	5				
2.1 EVM 连接	5				
2.2 EVM 设置	6				
2.3 测试设备	7				
2.4 建议的测试设置	7				
2.5 测试步骤	7				
3 测试数据和性能曲线	<mark>8</mark>				
3.1 效率和负载调节性能	<mark>8</mark>				
3.2 波形	9				
3.3 波特图	10				
3.4 EMI 性能	12				
4 EVM 文档	13				
4.1 原理图	13				
4.2 物料清单	14				
4.3 PCB 布局	16				
4.4 多层叠	18				
5 器件和文档支持	19				
5.1 器件支持	19				
5.2 文档支持	19				

# 插图清单

.0
. 8
.8
. 8
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.9
10
10
10
11
12
12
13
16
16
17
17
18
18
18

# 表格清单

表 1-1. TLVM13610 同步降压直流/直流电源模块系列	1
表 2-1. EVM 电源接头	5
表 2-2. EVM 信号接头	5
表 4-1. 元件 BOM	14



**商标** HotRod<sup>™</sup> is a trademark of Texas Instruments. WEBENCH<sup>®</sup> is a registered trademark of Texas Instruments. 所有商标均为其各自所有者的财产。



# 1 高密度 EVM 说明

TLVM13610EVM 具有 TLVM13610 同步降压电源模块,配置为在典型的 3V 至 36V 输入总线应用中运行。这种宽 V<sub>IN</sub> 范围的直流/直流解决方案提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。

可使用配置跳线将输出电压设置为 3.3V 或 5V,并且开关频率可分别设置为五个常用值(400kHz、700kHz、1MHz、1.4MHz 和 2.2MHz)中的一个。此外,EVM 的背面还有一个电阻占位符封装,允许在五个跳线设置之外 调整开关频率。

该 EVM 提供器件的完整 8A 输出电流额定值。选定的输入和输出电容器可在 EVM 上提供完整的输入电压范围和 所需的输出电压,可从多个元件供应商处获得。输入和输出电压检测端子和测试点接头有助于测量以下内容:

- 效率和功率耗散
- 线路和负载调节
- 负载瞬态响应
- 使能开/关
- 波特图 (交叉频率和相位裕度)

PCB 布局可更大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。

### 1.1 典型应用

- 测试和测量以及航天和国防
- 工厂自动化和控制、电力输送
- 需要负输出电压的反相降压/升压 (IBB) 电路

## 2 测试装置和过程

### 2.1 EVM 连接

参考表 2-1 中描述的 EVM 接头,使用图 2-1 中推荐的测试装置评估 TLVM13610。在提供 ESD 保护的工作站上 工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。



图 2-1. EVM 测试设置



### 表 2-1. EVM 电源接头

标签	说明
VIN+	正输入电源连接
VIN-	负输入电源连接
VOUT+	正输出电源连接
VOUT -	负输出电源连接

#### 表 2-2. EVM 信号接头

标签	说明				
VIN S+	正极输入感应端子。连接万用表正极引线,以测量效率。				
VIN S -	负极输入感应端子。连接万用表负极引线,以测量效率。				
VOUT S+	正极输出感应端子。连接万用表正极引线,以测量效率以及线路和负载调节。				
VOUT S -	负极输出感应端子。连接万用表负极引线,以测量效率以及线路和负载调节。				
GND	接地参考点				
SW	开关节点监控器输出				
EN	精密使能输入和输入电压 UVLO 保护。将 EN 连接到 GND,以禁用稳压器。使用逻辑信号控制 EN,以实现远程开和关功能。让 EN 开路,以使 UVLO 开启阈值设置为 6 V。				



#### 表 2-2. EVM 信号接头 (continued)

标签	说明
PG	电源正常监视器输出。PG 是一个带有 100k Ω 上拉电阻到 VOUT 的开漏标志。
CHA、CHB	波特图测量和信号注入。从 CHA 到 CHB 的 10 Ω 电阻有助于为波特图测量注入振荡器信号。移除跳线并在 CHA 和 CHB 之间施加扫频信号,同时测量每个端子的相应响应以进行环路增益测量。

### 2.2 EVM 设置

- 使用位于电源端子块附近的 VIN S+ 和 VIN S 测试点以及 VOUT S+ 和 VOUT S 测试点作为电压监测点, 通过连接电压表来分别测量输入和输出电压。*请勿将这些检测端子用作输入电源或输出负载连接点。*连接到这些检测端子的 PCB 迹线不能支持高电流。
- VOUT SELECT 接头 (J4) 允许选择 3.3V 或 5V。在为 EVM 供电之前,确保存在跳线并正确定位预期的输出电压。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。
- FSW SELECT 接头 (J5) 允许选择适合的开关频率:
  - 400kHz
  - 700kHz
  - 1 MHz
  - 1.4 MHz
  - 2.2 MHz

在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需开关频率。请务必在更改跳线设置之前 移除输入电源。

### 2.3 测试设备

电压源:输入电压源 V<sub>IN</sub> 必须能够提供 6A 的 36V 可变直流电源。

#### 万用表:

- **电压表 1**:测量 VIN S+ 至 VIN S- 的输入电压。
- **电压表 2**: 测量 VOUT S+ 至 VOUT S- 的输出电压。
- 电流表 1:测量输入电流。将电流表设置为具有 1 秒的孔径时间。
- 电流表 2:测量输出电流。将电流表设置为具有 1 秒的孔径时间。

**电子负载:**使用设置为恒定电阻 (CR) 或恒定电流 (CC) 模式的电子负载,并且能够支持 0ADC 到 6ADC。对于空载输入电流测量,请断开电子负载,因为它会消耗少量剩余电流。

**示波器:**将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出 电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地筒形 连接器固定到电容器的负极端子。TI不建议使用长引线接地,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要 测量其他波形,请根据需要调整示波器。

安全性:在接触任何可能带电或通电的电路时,请务必小心。

### 2.4 建议的测试设置

### 2.4.1 输入接头

- 在连接直流输入源之前,将输入电源的电流限制设置为最大 0.1A。确保输入源最初设置为 0V 并连接到 VIN+和 VIN 连接点,如图 2-1 所示。
- 在 VIN S+ 和 VIN S- 连接点上连接电压表 1, 以测量输入电压。
- 连接电流表 1,以测量输入电流,并将其设置为具有至少 0.1 秒的孔径时间。

#### 2.4.2 输出接头

- 将电子负载连接到 VOUT+和 VOUT 连接,如图 2-1 所示。在施加输入电压之前,将负载设置为恒阻模式或 恒流模式,电流为 0A。
- 在 VOUT S+ 和 VOUT S- 检测点上连接电压表 2,以测量输出电压。
- 连接电流表 2, 以测量输出电流。

### 2.5 测试步骤

#### 2.5.1 线路与负载调节和效率

- 按照*测试设置和程序*中的描述设置 EVM。
- 将负载设置为恒阻或恒流模式并具有 0A 的灌电流。
- 将输入源电压从 0V 增加到 24V;使用电压表 1 测量输入电压。
- 将输入电源的电流限值增加到8A。
- 使用电压表 2 测量输出电压 V<sub>OUT</sub>,并将负载电流从 0A 更改为 8A 直流; V<sub>OUT</sub> 必须保持在负载调节规格之内。
- 将负载电流设置为 4A (50% 额定负载)并将输入源电压从 6 V 更改为 36 V; V<sub>OUT</sub> 必须保持在线路调节规格 之内。
- 将负载电流设置为8A(100%额定负载)并测量典型输入电压(12V、24V和36V)下的效率。
- 将负载降低至 0A。将输入源电压降低至 0V。

### CAUTION

在高输出电流下长时间运行会使元件温度升高到 55°C 以上。为避免烧伤风险,请在断开电源后不要触摸元件,直到充分冷却为止。

# 3 测试数据和性能曲线

实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,因此这些曲线仅供参考,并可能与实际现场测量结果有所不同。除非另有指明,否则  $V_{IN}$  = 24V,  $V_{OUT}$  = 5V,  $I_{OUT}$  = 8 A 且  $F_{SW}$  = 1MHz。

### 3.1 效率和负载调节性能

本节提供 EVM 的效率和负载调节图。





#### 3.2 波形





测试数据和性能曲线



### 3.3 波特图

图 3-13 提供了 V<sub>IN</sub> = 24V、V<sub>OUT</sub> = 5V、F<sub>SW</sub> = 1MHz 且 I<sub>OUT</sub> = 8A 时的波特图。图 3-14 显示了 47μF、16V、 X6S 输出电容器的典型电容与电压关系曲线,以突出显示陶瓷元件的*有效* 电容值。请参阅*物料清单*中的元件详细 信息。



图 3-13. 具有四个 47µF、16V 输出电容器的波特图 (110µF 在 5VDC、25℃ 时有效 )









# 3.4 EMI 性能

有关通过 CISPR 11/32 B 类传导发射的输入 EMI 滤波器的详细信息,请参阅 原理图和物料清单。





# 4 EVM 文档

# 4.1 原理图

图 4-1 所示为 EVM 原理图。



图 4-1. EVM 原理图



### 4.2 物料清单

表 4-1. 元件 BOM

参考设计	数量	值	说明	封装	零件编号	制造商
C1	1	100µF	电容,铝,100μF,50V,0.34 Ω	8x10 UUD1H101MNL1GS		Nichicon
C2、C3、C4、C5	4	10µF	电容,陶瓷,10µF,50V,X7R	1210	GRM32ER71H106KA12L	MuRata
C6 , C7 , C8 , C9	4	2.2µF	电容,陶瓷,2.2µF,50V,X7R	0805	CGA4J3X7R1H225K125AB	ТDК
C10、C11、C12、C13	4	47µF	电容,陶瓷,47µF,16V,X6S	1210	GRM32EC81C476ME15L	MuRata
C14	1	0.1µF	电容,陶瓷,0.1µF,25V,X7R	0603	CGA3E2X7R1E104K080AA	ТDК
C15	1	1µF	电容,陶瓷,1µF,25V,X7R	0603	C0603C105K3RACTU	Kemet
C17	1	0.15µF	电容,陶瓷,0.15µF,50V,X7R	0603	CGA3E3X7R1H154K080AB	ТDК
C18	0	10pF	电容,陶瓷,10pF,50V,C0G/NP0	0402	CGA2B2C0G1H100D050BA	ТDК
H1、H2、H3、H4	4		六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙	-	1902C	Keystone
H5、H6、H7、H8	4		螺钉,盘头,4-40、3/8",尼龙	-	NY PMS 440 0038 PH	B&F Fastener Supply
J1、J2	2		端子块,2POS 5mm,TH	-	1729018	Phoenix Contact
J3 , J6	2		接头,100mil,3 x 1,金,TH	-	PBC03SAAN	Sullins Connector Solutions
J4	1		接头,100mil,2 x 1,金,TH	-	PBC02SAAN	Sullins Connector Solutions
J5	1		接头,100mil,5×2,锡,TH	-	PEC05DAAN	Sullins Connector Solutions
L1	1	1.5µH	屏蔽功率电感器 1.5μH 10.2A 10.5m Ω (最大值)	-	XGL4030-152MEC	Coilcraft
R1	1	0	电阻,0,5%,0.1W	0603	CRCW06030000Z0EA	Vishay-Dale
R2	1	0	电阻 , 0 , 0% , 0.2W	0402 CRCW04020000Z0EDHP		Vishay-Dale
R3	1	<b>187k</b> Ω	电阻,187k <sup>Ω</sup> ,1%,0.1W	0603 CRCW0603187		Vishay-Dale
R4	1	<b>49.9k</b> Ω	电阻,49.9kΩ,1%,0.1W	0603 CRCW060349K9FKEA		Vishay-Dale
R5	1	<b>10</b> Ω	电阻,10.0 Ω,1%,0.063W	V 0402 CRCW040210R0FKED		Vishay-Dale
R6	1	100k Ω	电阻,100k Ω,1%,0.1W	0603 CRCW0603100KFKEA		Vishay-Dale
R7	1	100k Ω	电阻,100k Ω,1%,0.063W	0402	CRCW0402100KFKED	Vishay-Dale
R8	1	<b>43.2k</b> Ω	电阻,43.2k Ω,1%,0.063W	0402	CRCW040243K2FKED	Vishay-Dale
R9	1	59.0k Ω	电阻,59.0kΩ,1%,0.063W	0402	CRCW040259K0FKED	Vishay-Dale
R10	1	<b>40.2k</b> Ω	电阻,40.2k♀,1%,0.063W	0402	CRCW040240K2FKED	Vishay-Dale
R11	1	<b>22.6k</b> Ω	电阻,22.6k Ω,1%,0.063W	0402	CRCW040222K6FKED	Vishay-Dale
R12	1	15.8k Ω	电阻,15.8k Ω,1%,0.063W	0402	CRCW040215K8FKED	Vishay-Dale
R13	1	11.0k Ω	电阻,11.0kΩ,1%,0.063W	0402	CRCW040211K0FKED	Vishay-Dale
R14	1	<b>6.8k</b> Ω	电阻,6.8kΩ,5%,0.063W	0402	CRCW04026K80JNED	Vishay-Dale
R15	0	<b>4.99k</b> Ω	电阻,4.99kΩ,1%,0.063W	0402	CRCW04024K99FKED	Vishay-Dale
R17	0	<b>4.99M</b> Ω	电阻,4.99M Ω,1%,0.1W	0603	CRCW06034M99FKEA	Vishay-Dale
SH-J1、SH-J2、SH-J3、 SH-J4、SH-J5、SH-J6	6	1 × 2	分流器,100mil,镀金,黑色	分流器	SNT-100-BK-G	Samtec
TP1 , TP2 , TP3 , TP4 , TP5 , TP6 , TP7 , TP8	8		测试点,微型,SMT	-	5019	Keystone



### 表 4-1. 元件 BOM (continued)

参考设计	数量	值	说明	封装	零件编号	制造商
U1	1		TLVM13610RDFR	B3QFN-22	TLVM13610RDFR	德州仪器 (TI)



# 4.3 PCB 布局

图 4-2 至图 4-7 显示了 PCB 布局图像,包括 3D 视图、铜层、装配图和层堆叠图。该 PCB 为 62 密耳标准厚度,所有层均为 2 盎司覆铜。



图 4-2. 3D 顶视图



图 4-3.3D 底视图





图 4-4. 顶部铜层



图 4-5. 第 2 层覆铜





图 4-6. 第 3 层覆铜



图 4-7. 底部铜层(顶视图)

### 4.4 多层叠

_						
#	Name	Material	Туре	Weight	Thickness	Dk
	Top Overlay		Overlay			
	Top Solder	Solder Resist 🔤	Solder Mask		0.4mil	3.5
1	Top Layer		Signal	2oz	2.8mil	
	Dielectric1	FR-4 High Tg 🛛 🔤	Core		5mil	4.8
2	Signal Layer 1		Signal	2oz	2.8mil	
	Dielectric3		Dielectric		40mil	4.8
з	Signal Layer 2		Signal	2oz	2.8mil	
	Dielectric2		Dielectric		5mil	4.8
4	Bottom Layer		Signal	2oz	2.8mil	
	Bottom Solder	Solder Resist 🔤	Solder Mask		0.4mil	3.5
	Bottom Overlay		Overlay			



### 5 器件和文档支持

### 5.1 器件支持

### 5.1.1 开发支持

相关开发支持请参阅以下资源:

- 有关 TI 的参考设计库,请访问 TI 参考设计库
- 有关 TI WEBENCH 设计环境,请访问 WEBENCH<sup>®</sup> 设计中心
- 要设计低 EMI 电源,请查看 TI 的全面 EMI 培训系列
- 要设计反相降压/升压 (IBB) 稳压器,请访问 直流/ 直流反相降压/升压模块
- TI 参考设计:
  - 适用于 Kintex 7 应用的多输出电源解决方案
  - Arria V 电源参考设计
  - Altera Cyclone V SoC 电源参考设计
  - 具有超低 BOM 数量的空间优化型直流/直流反相电源模块参考设计
  - 适用于小型低噪声系统的 3 至 11.5V<sub>IN</sub>、 5V<sub>OUT</sub>、1.5A 反相电源模块参考设计
- 技术文章:
  - 使用直流/直流降压转换器为医学成像应用供电
  - 如何构建可编程输出反相降压/升压稳压器
- 要查看本产品的相关器件,请参阅 LM61495 36V、10A 同步降压转换器

### 5.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案

- 1. 首先键入输入电压 ( $V_{IN}$ )、输出电压 ( $V_{OUT}$ )和输出电流 ( $I_{OUT}$ )要求。
- 2. 使用优化器表盘优化该设计的关键参数,如效率、占用空间和成本。
- 3. 将生成的设计与德州仪器 (TI) 其他可行的解决方案进行比较。

WEBENCH Power Designer 提供了定制原理图,并罗列了实时价格和元件供货情况的物料清单。

在多数情况下,可执行以下操作:

- 运行电气仿真,观察重要波形以及电路性能。
- 运行热性能仿真,了解电路板热性能。
- 将定制原理图和布局方案以常用 CAD 格式导出。
- 打印设计方案的 PDF 报告并与同事共享。

有关 WEBENCH 工具的详细信息,请访问 www.ti.com.cn/WEBENCH。

### 5.2 文档支持

### 5.2.1 相关文档

请参阅如下相关文档:

- 德州仪器 (TI), 创新型直流/直流电源模块 选择指南
- 德州仪器 (TI),使用增强型 HotRod™ QFN 封装技术实现具有出色热性能的小型低噪电源模块 白皮书
- 德州仪器 (TI), 各种电源模块封装选项的优缺点 白皮书
- 德州仪器 (TI), 借助电源模块简化低 EMI 设计 白皮书
- 德州仪器 (TI), 适用于实验室仪表的电源模块 白皮书
- 德州仪器 (TI), 有关直流/直流稳压器 EMI 的工程师指南 电子书
- 德州仪器 (TI), *电源模块的焊接注意事项* 应用报告
- 德州仪器 (TI), 采用直流/直流电源模块的实用性热设计 应用报告
- 德州仪器 (TI), 使用新的热指标 应用报告
- 德州仪器 (TI), AN-2020 热设计: 学会洞察先机, 不做事后诸葛 应用报告
- 德州仪器 (TI), 采用 TPSM53602/3/4 实现负输出反相降压/升压应用应用报告

### 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司